

ПРОГРАММА

Школы молодых ученых «Актуальные проблемы полупроводниковых наносистем»

29 октября 2025 г.

ИФП СО РАН, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева 13, конференц-зал (3 этаж)



8:30 – 9:00	Регистрация участников Школы		
9:00 – 9:15	Открытие – вступительное слово Латышев Александр Васильевич		
9:15 – 9:40	<u>Роголо Дмитрий Игоревич</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Развитие методов эпитаксии слоистых материалов для устройств гибкой электроники
9:40 – 10:05	<u>Басова Тамара Валерьевна</u>	ИНХ СО РАН, г. Новосибирск	Гибридные материалы на основе фталоцианинов металлов в качестве активных слоев адсорбционно-резистивных газовых сенсоров
10:05 – 10:30	<u>Антонова Ирина Вениаминовна</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Тестирование активности нервной системы человека сенсором на основе графена
10:30 – 10:55	<u>Доровских Светлана Игоревна</u>	ИНХ СО РАН, г. Новосибирск	Атомно слоевое осаждение: от прекурсора к практическому приложению
10:55 – 11:20	Перерыв, кофе-брейк		
11:20 – 11:45	<u>Семенова Ольга Ивановна</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Метод Лэнгмюра-Блоджетт для синтеза полупроводниковых наночастиц
11:45 – 12:10	<u>Васильев Владислав Юрьевич</u>	НГТУ, г. Новосибирск	Необходимость, достоинства и "подводные камни" формирования нанотолщинных материалов для электроники методом атомно-слоевого осаждения
12:10 – 12:35	<u>Баранов Евгений Александрович</u>	ИТ СО РАН, г. Новосибирск	Металл-индуцированная кристаллизация тонких пленок аморфных полупроводников
12:35 – 13:00	<u>Кулик Леонид Викторович</u>	ИХКГ СО РАН, г. Новосибирск	Модификация активного слоя органических фотовольтаических ячеек углеродными нанотрубками
13:00 – 14:00	Обед		
14:00 – 14:25	<u>Гейдт Павел Викторович</u>	НГУ, г. Новосибирск	Электриды: разновидности, получение, свойства и применение
14:25 – 14:50	<u>Косинова Марина Леонидовна</u>	ИНХ СО РАН, г. Новосибирск	Эволюция кремнийорганических прекурсоров для изготовления low-k диэлектриков
14:50 – 15:15	<u>Исламов Дамир Ревинирович</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Перспективные материалы и методы для металлизации интегральных микросхем

15:15 – 17:30	Представление стендов участниками Школы
	Перерыв, кофе-брейк
	Стендовая сессия
17:30 – 18:00	Вручение Дипломов. Закрытие Школы

Стендовая сессия, 29 октября, 15:15 – 17:30, холл перед конференц-залом

<i>№ стенда</i>	<i>Докладчик</i>	<i>Организация</i>	<i>Название доклада</i>
1	<u>Беспалова Арина Дмитриевна</u>	Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск	<i>Морфология пленок V_2O_5, полученных методом атомно-слоевого осаждения на поверхности SiO_2</i>
2	<u>Богословцева Алена Леонидовна</u>	Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск	<i>Структура пьезоэлектрических пленок AlN, полученных методом магнетронного распыления на $Si(100)$</i>
3	<u>Воронковский Виталий Александрович</u>	Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, г. Новосибирск	<i>Оптические свойства нестехиометрических оксидов титана</i>
4	<u>Гришин Никита Сергеевич</u>	Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск	<i>Генерация и рассеяние поверхностных волн Дьяконова в системах на основе жидких кристаллов</i>
5	<u>Дураков Денис Евгеньевич</u>	Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, г. Новосибирск	<i>In situ отражательная электронная микроскопия графитизации поверхности подложки $6H-SiC(0001)$ при высокотемпературном отжиге</i>
6	<u>Егоров Дмитрий Александрович</u>	Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск	<i>Измерения холловской электронной вязкости</i>
7	<u>Захарук Юлия Сергеевна</u>	Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск	<i>Формирование $GeSi$ наноостровков при эпитаксии из ионно-молекулярных пучков</i>
8	<u>Захожев Константин Евгеньевич</u>	Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск	<i>Структурная трансформация поверхности $Bi_2Se_3(0001)$ при отжиге с покрытием Sn</i>
9	<u>Ибятков Тимур Маратович</u>	Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск	<i>Смешанные механизмы возбуждения и детектирования в нанoeлектромеханических системах с двумерным электронным газом</i>

10	<u>Иванова Софья</u> <u>Максимовна</u>	Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск	<i>Магнитный топологический изолятор на $MnBi_2Te_4$, выращенный с помощью МЛЭ</i>
11	<u>Калинина</u> <u>Владислава</u> <u>Богдановна</u>	Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск	<i>Исследование электрических и оптических свойств диоксида ванадия с фазовым переходом полупроводник-металл</i>
12	<u>Кислухин</u> <u>Никита</u> <u>Александрович</u>	Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск	<i>Модификация оптических свойств тонких пленок GeO_x на стекле в области края собственного поглощения с помощью отжигов</i>
13	<u>Клямер Дарья</u> <u>Дмитриевна</u>	Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, г. Новосибирск	<i>Октагалогензамещенные фталоцианины металлов и гибридные материалы на их основе</i>
14	<u>Кобелева Елена</u> <u>Сергеевна</u>	Институт химической кинетики и горения им В. В. Воеводского СО РАН, г. Новосибирск	<i>Летучая добавка для модификации морфологии нефуллереновых акцепторов в активном слое органических солнечных элементов</i>
15	<u>Кукунов Олжас</u> <u>Игоревич</u>	Томский государственный университет, г. Томск	<i>Влияние послеростового отжига на параметры самоорганизованных Ми резонаторов</i>
16	<u>Курмачев</u> <u>Дмитрий</u> <u>Андреевич</u>	Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск	<i>Температурная зависимость аномальных флуктуаций кондактанса в мезоскопической структуре на основе $HgTe$ квантовой ямы</i>
17	<u>Кырова</u> <u>Екатерина</u> <u>Денисовна</u>	Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск	<i>Исследование морфологии поверхности плёнок $(MnTe)_m(Bi_2Te_3)_n$ на подложках $Si(111)$</i>
18	<u>Маркелова</u> <u>Алина</u> <u>Константиновна</u>	Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, г. Новосибирск	<i>Кристаллическая структура тонких плёнок нестехиометрических оксидов титана</i>
19	<u>Миллюшин</u> <u>Дмитрий</u> <u>Максимович</u>	Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск	<i>Формирование и исследование нелинейных резистивных переключателей на основе микроструктур диоксида ванадия</i>
20	<u>Миронов</u> <u>Никита</u> <u>Алексеевич</u>	Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск	<i>Моделирование гибридных динамически перестраиваемых материалов ИК диапазона на основе диоксида ванадия и кремния</i>
21	<u>Молчанов Иван</u> <u>Алексеевич</u>	Институт химической кинетики и горения им В. В. Воеводского СО РАН, г. Новосибирск	<i>Влияние объёмного электрода на основе наногибрида Ф- МУНТ/PEDOT:PSS на фотовольтаические параметры органической солнечной ячейки</i>

22	<u>Нефедов</u> <u>Алексей</u> <u>Владимирович</u>	Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, г. Новосибирск	<i>Накопление зарядов и фотолюминесценция в плёнках SiO_2, имплантированных ионами In^+ и As^+</i>
23	<u>Плетнев</u> <u>Владислав</u> <u>Владимирович</u>	Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск	<i>Оптический спин поляризованный сканирующий туннельный микроскоп</i>
24	<u>Плотников</u> <u>Никита</u> <u>Владимирович</u>	Томский государственный университет, г. Томск	<i>Особенности синтеза германия на поверхности высокоориентированного пиролитического графита</i>
25	<u>Самусь Алексей</u> <u>Дмитриевич</u>	Сибирский государственный университет науки и технологий им. ак. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск	<i>Исследование технологии получения плёнок GeO методом термического испарения в условиях низкого вакуума</i>
26	<u>Сарыпов</u> <u>Даниил</u> <u>Игоревич</u>	Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск	<i>Вязкий бездиссипативный поток электронов в GaAs микросужениях</i>
27	<u>Силайчев</u> <u>Данил</u> <u>Вячеславович</u>	Сибирский государственный университет науки и технологий им. ак. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск	<i>Влияние наклонного напыления и отжига на магнитную анизотропию плёнок $\text{Co/MgO}(100)$. Эксперимент и моделирование</i>
28	<u>Тараненко Анна</u> <u>Васильевна</u>	Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск	<i>Комбинационное рассеяние света и фотолюминесценция нанопроволок GaP с прямозонными вставками GaPAs</i>
29	<u>Хертухеев Петр</u> <u>Михайлович</u>	Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск	<i>Влияние параметров плазмохимического травления на формирование масок SiN_x</i>